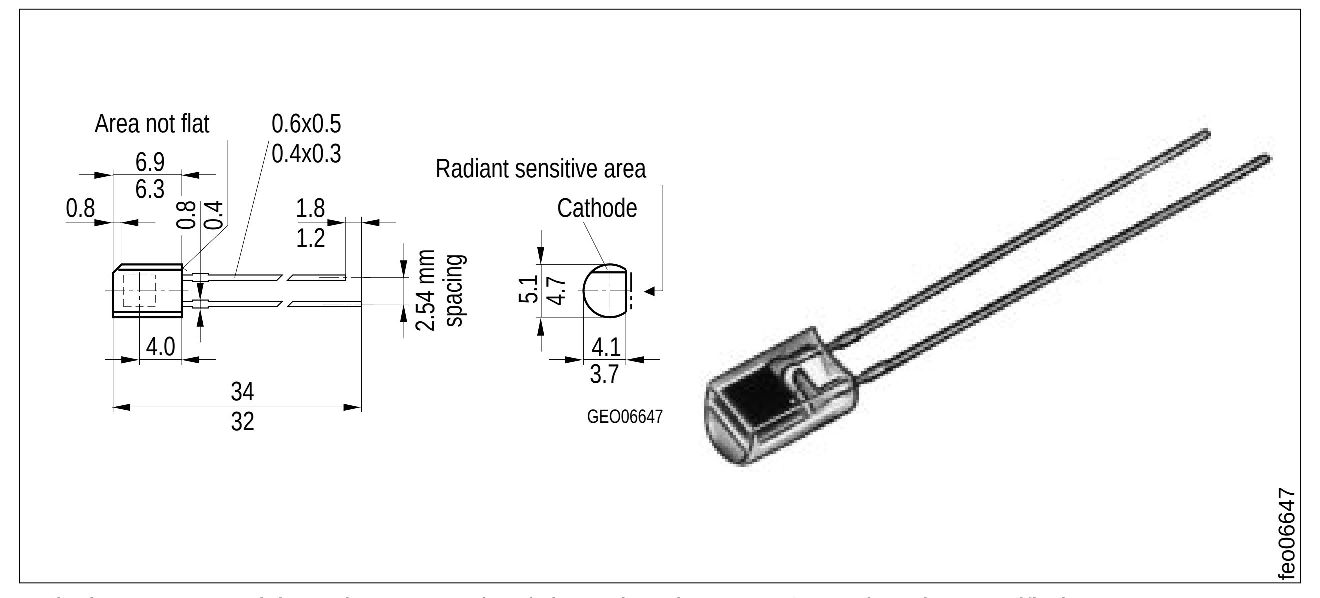
Silizium-PIN-Fotodiode
Silicon PIN Photodiode

SFH 206 K



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5-mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Computer-Blitzlichtgeräte
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- “Messen/Steuern/Regeln”

Features

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- Computer-controlled flashes
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
SFH 206 K	Q62702-P129

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung **Description**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}; T_{stg}	– 40 ... + 100	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \leq 3$ s)	T_S	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	32	V
Verlustleistung, T_A = 25 °C Total power dissipation	P_{tot}	150	mW

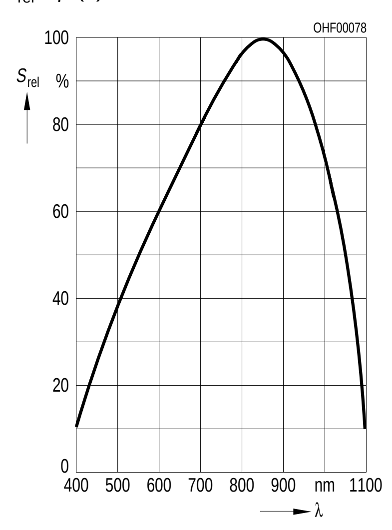
Kennwerte (T_A = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K)
Characteristics (T_A = 25 °C, standard light A, T = 2856 K)

Bezeichnung **Description**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Fotoempfindlichkeit, V_R = 5 V Spectral sensitivity	S	80 (≥ 50)	nA/lx
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\,max}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von S_{max} Spectral range of sensitivity S = 10 % of S_{max}	λ	400 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	7.00	mm^2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.65 × 2.65	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	1.2 ... 1.4	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, V_R = 10 V Dark current	I_R	2 (≤ 30)	nA

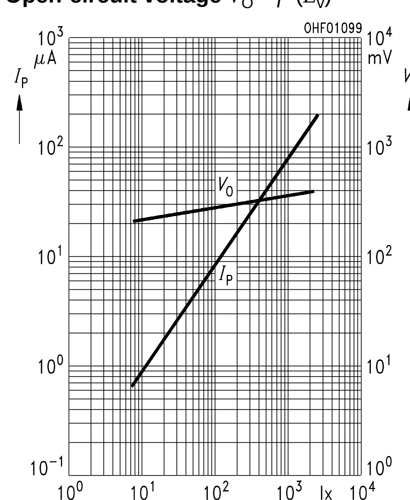
Kennwerte (T_A = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K)
Characteristics (T_A = 25 °C, standard light A, T = 2856 K) (cont'd)

Bezeichnung **Description**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Spektrale Fotoempfindlichkeit, λ = 850 nm Spectral sensitivity	S_λ	0.62	A/W
Quantenausbeute, λ = 850 nm Quantum yield	η	0.90	$\frac{\text{Electrons}}{\text{Photon}}$
Leerlaufspannung, E_v = 1000 lx Open-circuit voltage	V_O	365 ($\geq$ 310)	mV
Kurzschlußstrom, E_v = 1000 lx Short-circuit current	I_{SC}	80	µA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent R_L = 50 Ω; V_R = 5 V; λ = 850 nm; I_p = 800 µA	t_r, t_f	20	ns
Durchlaßspannung, I_F = 100 mA, E = 0 Forward voltage	V_F	1.3	V
Kapazität, V_R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance	C_0	72	pF
Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O	TC_V	– 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC} Temperature coefficient of I_{SC}	TC_I	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power V_R = 10 V, λ = 850 nm	NEP	4.2×10^{-14}	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, V_R = 10 V, λ = 850 nm Detection limit	D*	6.3×10^{12}	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

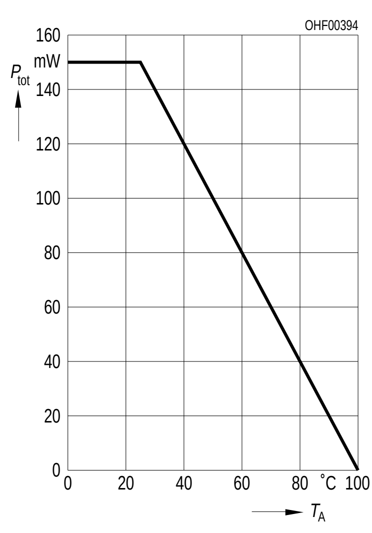
Relative spectral sensitivity
$S_{rel} = f\ (\lambda)$



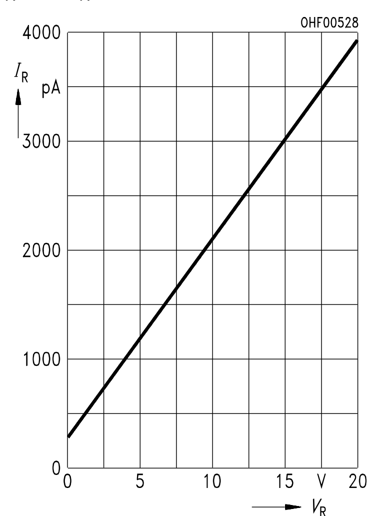
Photocurrent $I_P = f\ (E_v)$, V_R = 5 V
Open-circuit voltage $V_O = f\ (E_v)$



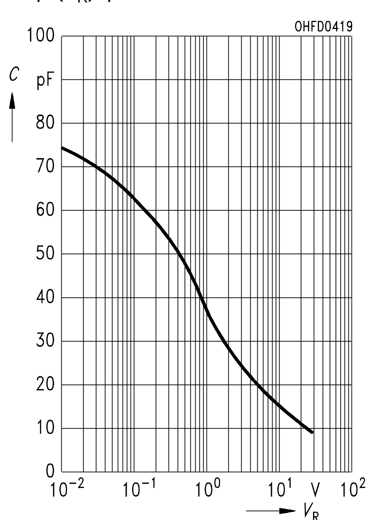
Total power dissipation
$P_{tot} = f\ (T_A)$



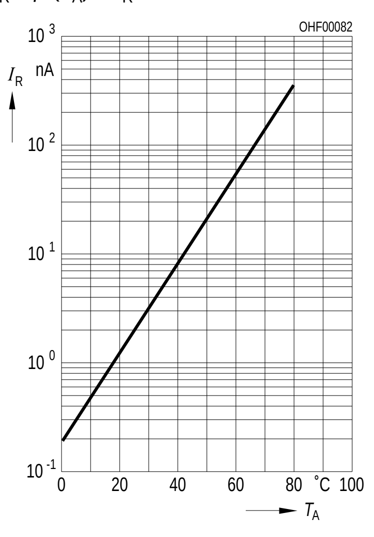
Dark current
$I_R = f\ (V_R)$, E = 0



Capacitance
$C = f\ (V_R)$, f = 1 MHz, E = 0



Dark current
$I_R = f\ (T_A)$, V_R = 10 V, E = 0



Directional characteristics $S_{rel} = f\ (\varphi)$

